

Низкие динамические потери
 Малый заряд обратного восстановления
 Разветвленный управляющий электрод для
 высоких скоростей нарастания тока

Быстродействующий Импульсный Тиристор Тип ТБИ153-800-15

Средний прямой ток		I_{TAV}	800 А	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии		U_{DRM}	1000 ÷ 1500 В	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение		U_{RRM}		
Время выключения		t_q	10.0; 12.5; 16.0 мкс	
U_{DRM} , U_{RRM} , В	1000	1200	1400	1500
Класс по напряжению	10	12	14	15
T_j , °C			– 60 ÷ 125	

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{TAV}	Средний ток в открытом состоянии	А	800 1180	$T_c=85$ °C; двухстороннее охлаждение; $T_c=55$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии	А	1255	$T_c=85$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии	кА	19.0 21.8	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			20.0 23.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
I^2t	Защитный фактор	$A^2 \cdot 10^3$	1800 2375	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			1660 2195	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс

Блокирующие параметры				
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1000÷1500	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1100÷1600	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто
U_D, U_R	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.75 \cdot U_{DRM}$ $0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\ max}$; управление разомкнуто
Параметры управления				
I_{FGM}	Максимальный прямой ток управления	А	8	$T_j = T_{j\ max}$
U_{RGM}	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
P_G	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	8	
Параметры переключения				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f=1$ Hz)	А/мкс	2000	$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; $I_{TM} = 2 I_{TAV}$; Импульс управления: $I_G = I_{FGM}$; $U_G = 20$ В; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt = 1$ А/мкс
Тепловые параметры				
T_{stg}	Температура хранения	°C	- 60 ÷ 125	
T_j	Температура р-п перехода	°C	- 60 ÷ 125	
Механические параметры				
F	Монтажное усилие	кН	24.0÷28.0	
a	Ускорение	м/с ²	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии

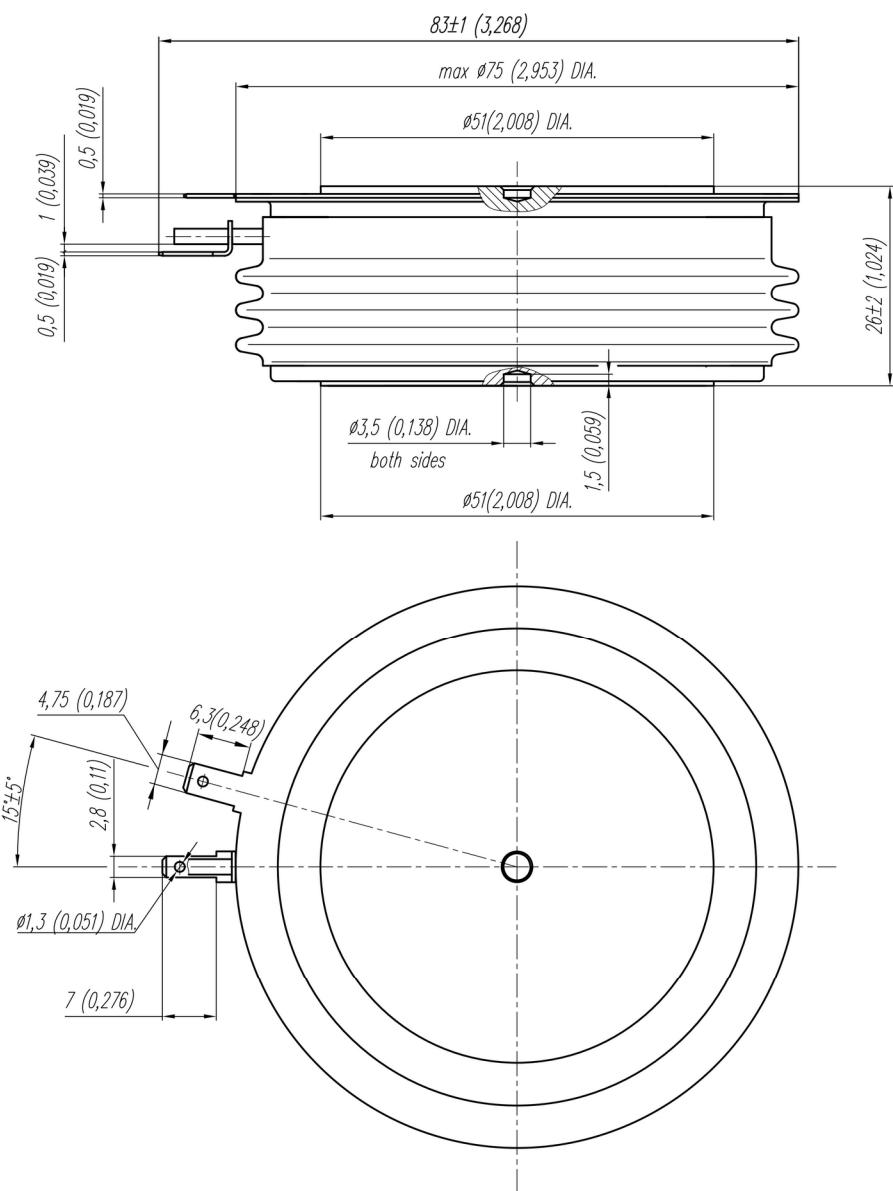
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики	Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Характеристики в проводящем состоянии				
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	2.50	$T_j = 25$ °C; $I_{TM} = 2512$ А
$U_{T(to)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.40	$T_j = T_{j\ max}$;
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	0.49	
I_H	Ток удержания, макс	мА	500	$T_j = 25$ °C; $U_D = 12$ В; управление разомкнуто
Блокирующие характеристики				
I_{DRM}, I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	150	$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = U_{DRM}$; $U_R = U_{RRM}$
$(dv_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии ¹⁾ , мин	В/мкс	1000	$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; управление разомкнуто

Характеристики управления											
U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	V	4.00 2.50 2.00	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^\circ C$ $T_j = T_{j \max}$	$U_D = 12 V; I_D = 3 A;$ Постоянный ток управления						
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, макс	mA	500 300 200	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^\circ C$ $T_j = T_{j \max}$							
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	V	0.25	$T_j = T_{j \max};$ $U_D = 0.67 U_{DRM};$	Постоянный ток управления						
I_{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	mA	10.00								
Динамические характеристики											
t_{gd}	Время задержки включения	мкс	2.0	$T_j = 25^\circ C; V_D = 0.4 V_{DRM}; I_{TM} = I_{TAV};$ Gate pulse: $I_G = I_{FGM}; V_G = 20 V;$ $t_{GP} = 50 \mu s; di_G/dt = 1 A/\mu s$							
t_q	Время выключения ²⁾ , макс	мкс	10.0; 12.5; 16.0	$dv_D/dt = 50 V/\mu s;$	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di_R/dt = -10 A/\mu s;$ $U_R = 100 V;$ $U_D = 0.67 U_{DRM}$						
			12.5; 16.0; 20.0	$dv_D/dt = 200 V/\mu s;$							
Q_{rr}	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	200	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di_R/dt = -50 A/\mu s;$ $U_R = 100 V$							
t_{rr}	Время обратного восстановления, макс	мкс	4.0								
I_{rrM}	Ток обратного восстановления, макс	A	115								
Тепловые характеристики											
R_{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	°C/Вт	0.0210	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение						
R_{thjc-A}			0.0462		Охлаждение со стороны анода						
R_{thjc-K}			0.0378		Охлаждение со стороны катода						
R_{thck}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	°C/Вт	0.004	Постоянный ток							
Механические характеристики											
w	Масса, тип	г	550								
D_s	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	29.47 (1.160)								
D_a	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	17.50 (0.689)								
ПРИМЕЧАНИЕ			МАРКИРОВКА								
1) Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии			ТБИ	153	800	15	A2	A4	УХЛ2		
			1	2	3	4	5	6	7		
Обозначение группы	A2		1. Быстродействующий импульсный тиристор								
$(dv_D/dt)_{crit}, V/\mu s$	1000		2. Конструктивное исполнение								
2) Время выключения ($dv_D/dt = 50 V/\mu s$)			3. Средний ток в открытом состоянии, А								
			4. Класс по напряжению								
Обозначение группы	A4	X3	5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии								
$t_q, \mu s$	10.0	12.5	6. Группа по времени выключения ($dv_D/dt = 50 V/\mu s$)								
			7. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т								

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: Т.D2



Все размеры в миллиметрах (дюймах)